

### 关键指标

频率: 6~18GHz  
功率增益: 19dB  
1dB 压缩点输出功率: 28dBm  
饱和输出功率: 30dBm  
功率附加效率: 26%  
电压/电流: +5V/590mA  
芯片尺寸: 3mm×2.29mm×0.1mm

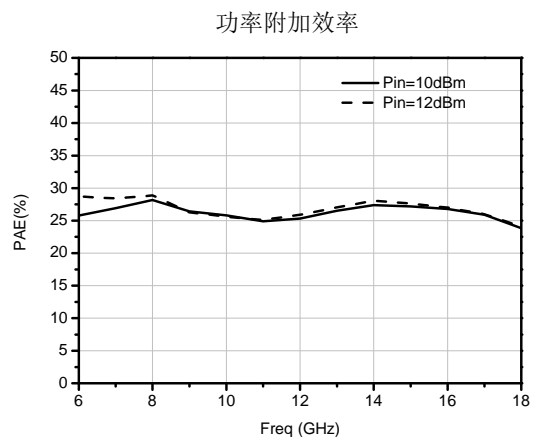
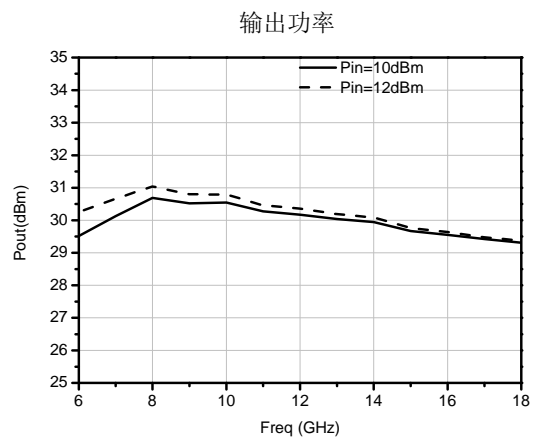
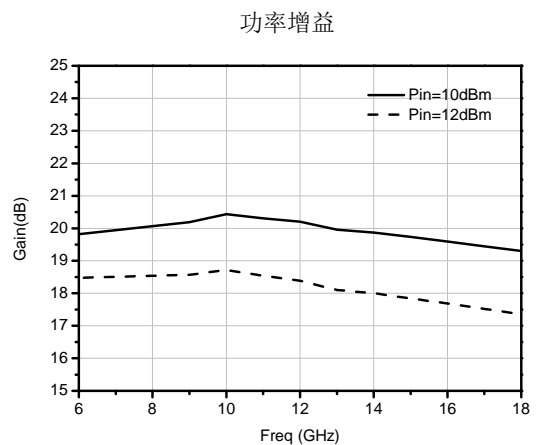
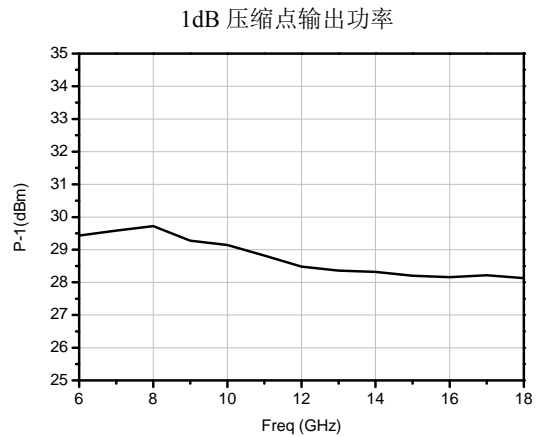
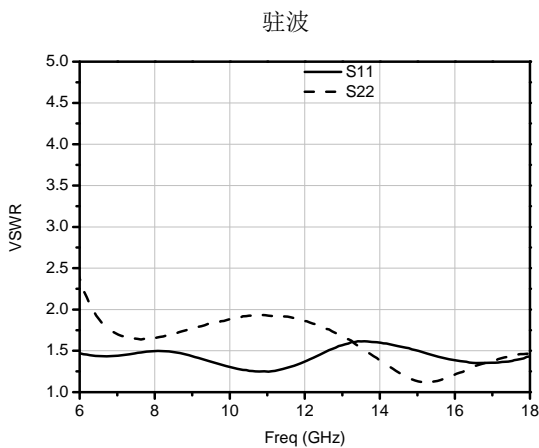
### 产品简介

HG136F-3 是一款 6~18GHz 功率放大器芯片, 功率增益为 19dB, 饱和输出功率为 30dBm, 功率附加效率为 26%。

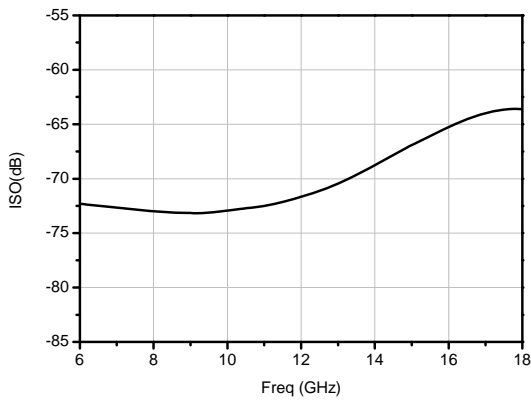
### 电性能 ( $T_A=25^\circ\text{C}$ , $V_{dd}=+5\text{V}$ , $V_g=-1\text{V}$ )

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	6~18		
功率增益(dB)	-	19	-
增益平坦度(dB)	-	±1	-
输入驻波	-	1.4	-
输出驻波	-	1.5	-
1dB 压缩点输出功率(dBm)	-	28	-
饱和输出功率(dBm)	-	30	-
功率附加效率	-	26%	-
静态电流 (mA)	-	590	-

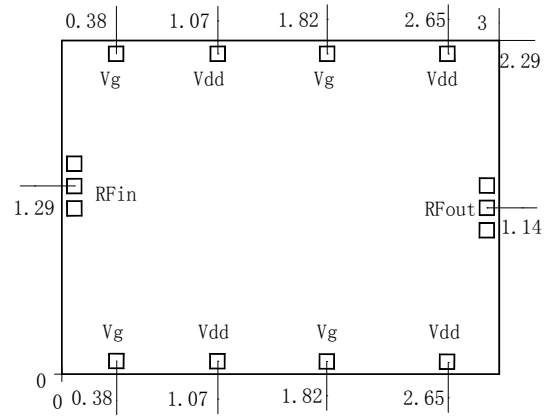
### 典型测试曲线



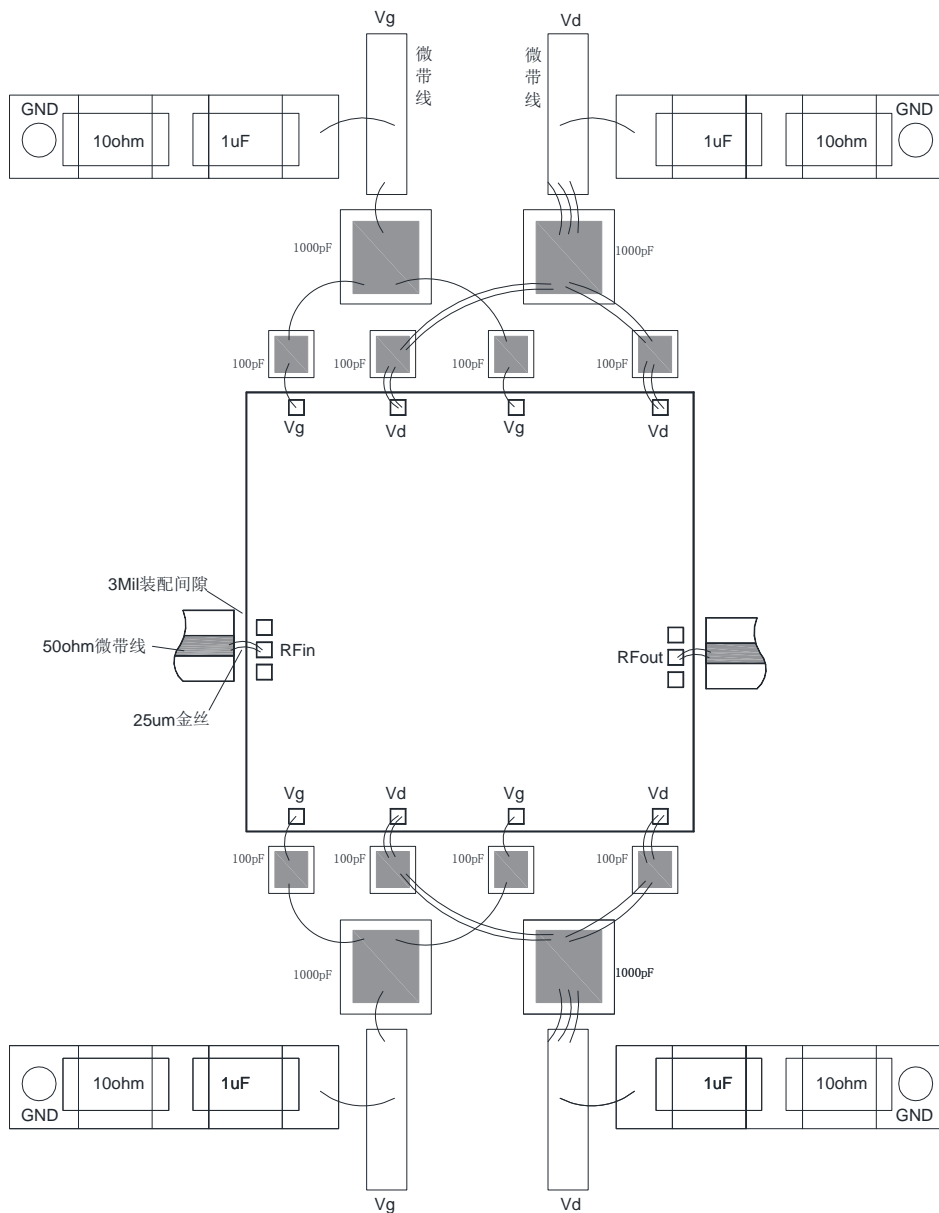
反向隔离度



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

电源电压	+7V
最大输入功率	+25dBm
工作温度	-55℃~85℃
存储温度	-65℃~150℃

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用 50μm 双金带键合，建议金带长度 250~400μm；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。